

## Розділ 3.7. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СИНАПС

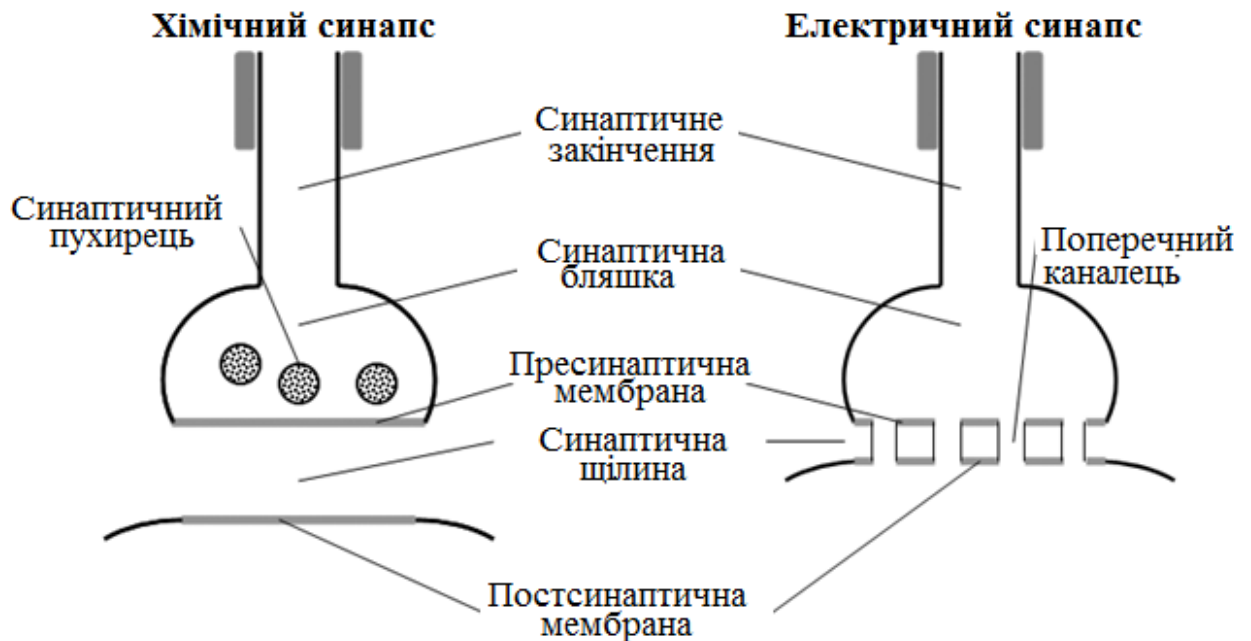
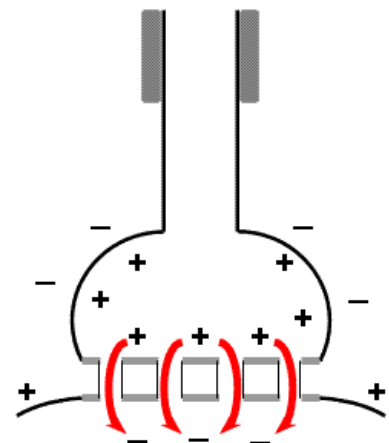


Рис. 1. Особливості ультраструктури електричного синапса

Вузька (близько 5 нм) синаптична щілина; наявність поперечних каналців, що з'єднують пресинаптичну і постсинаптичну мембрану.

### МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ СИНАПСІ

Механізм проведення збудження аналогічний механізму проведення збудження в нервовому волокні. Під час розвитку ПД відбувається реверсія заряду пресинаптичної мембрани. Електричний струм, що виникає між пресинаптичної і постсинаптичної мембраною, подразнює постсинаптичну мембрану і викликає генерацію в ній ПД.



### ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИНАПСІВ

1. Двостороннє проведення збудження
2. Низька стомлюваність – відповідає стомлюваності нервового волокна
3. Синаптична затримка – коротка
4. Чутливість до дії електромагнітних випромінювань